

新製品



SANYO

2SC3455

シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ
スイッチング電源用

暫定規格

特長・高耐圧, 高信頼性である。

- ・スイッチングスピードが速い。(tf : typ 0.1μs)
- ・ASOが広い。
- ・MBITプロセス採用

用途・スイッチング電源用

絶対最大定格/Ta=25°C

			unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	800	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	500	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	7	V
コレクタ電流	I _C	25	A
ピークコレクタ電流	i _{cp} ※	40	A
ベース電流	I _B	8	A
コレクタ損失	P _C	160	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

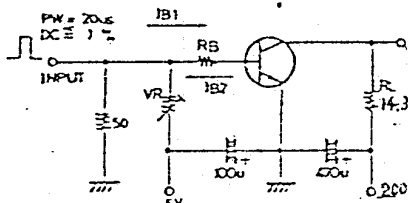
TC = 25°C

※パルス PW ≤ 300μs, Duty Cycle ≤ 10%

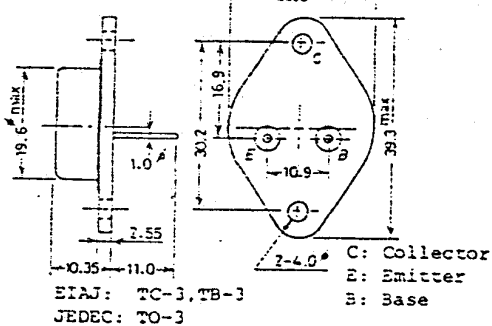
電気的特性/Ta=25°C

		MIN	TYP	MAX	unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	VCB=500V, I _E =0		10	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	VEB=5V, I _C =0		10	μA
直流電流増幅率	h _{FE} (1)	V _{CE} =5V, I _C =2.4A	10		
	h _{FE} (2)	V _{CE} =5V, I _C =12A	8		
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =10V, I _C =2.4A	18		MHz
出力容量	C _{ob}	VCB=10V, f=1MHz	320		PF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =12A, I _B =2.4A		1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =12A, I _B =2.4A		1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	V(BR) _{CB0}	I _C =1mA, I _E =0	800		V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V(BR) _{CE0}	I _C =5mA, R _{BE} =∞	500		V
エミッタ・ベース降伏電圧	V(BR) _{EB0}	I _E =1mA, I _C =0	7		V
コレクタ・エミッタ維持電圧	V _{CEO(sus)}	I _C =20A, I _B =4A L=50μH	500		V
"	V _{CEX(sus)}	I _C =10A I _{B1} =-I _{B2} =4A L=200μH, Clamped V _{CC} =200V	500		V
上昇時間	t _{on}	5I _{B1} =-2.5I _{B2} =I _C =14A RL=14.3Ω		0.5	μs
蓄積時間	t _{stg}			3.0	μs
下降時間	t _f			0.3	μs

スイッチングタイム測定回路



外形図
(単位: mm)



これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。